

The logo for GEMaC features a series of thin, curved lines that sweep from the left side of the page towards the right, arching over the letters 'GEMaC'.

GEMaC

Groupe c de la Matière Con

MOCVD DES SEMICONDUCTEURS II-VI

Le GEMaC possède deux bâtis de croissance MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) dédiés à la croissance de structures à base de semi-conducteurs II/VI.

Bâti à réacteur horizontal (SAT)

Principales caractéristiques du bâti :

Sources :

- Eléments II : Zn, Mg, Cd
- Elements III : Ga
- Eléments VI : N₂O, O₂, t-butanol
- Dopage : Al, Ga, Sb, NH₃

Gaz vecteur : He, H₂, Ar, N₂

Pression : 30 torr P. atmosphérique

Température : chauffage RF 1000°C

Taille des substrats : jusqu'à 2x2"



Bâti à réacteur vertical

Principales caractéristiques du bâti :

Sources

- Eléments II : Zn, Mg
- Eléments VI : N₂O, t-butanol, Se, Te, S
- Dopage : Al, Ga

Gaz vecteur : He, H₂, Ar, N₂

Pression : atmosphérique

Température : chauffage RF 1000°C

Taille des substrats 1 à 2 cm²

